

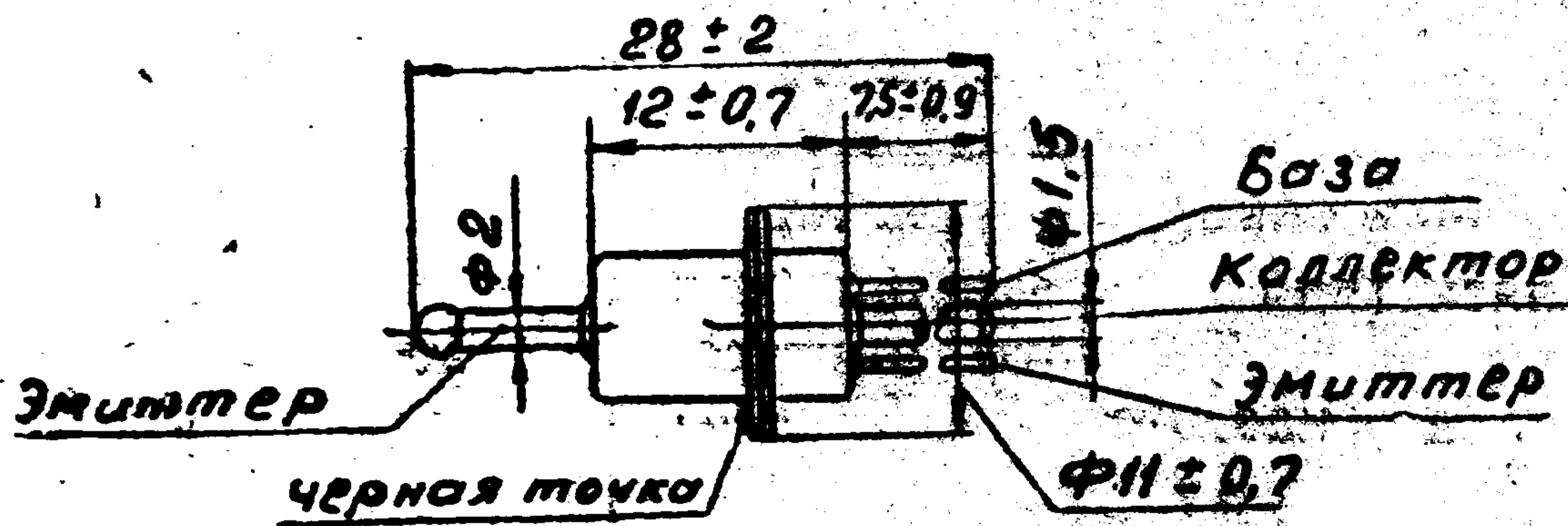
Паспорт (этикетка)

ТРАНЗИСТОРЫ

германиевые диффузионные р-п-р типов:

П410, П410А, П411, П411А

СБО.336.011 ТУ



**Основные технические данные в схеме с общей базой
при температуре $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$**

	П410	П410А	П411	П411А
Коэффициент усиления по току *	27-120	80-250	27-120	80-250
Выходная проводимость *, <i>мкма</i> , не более	10			
Начальный ток коллектора (при напряжении коллектора минус 8 в и сопротивлении в цепи базы равном нулю), <i>мка</i> , не более	5			
Обратный ток коллектора (при напряжении коллектора минус 5 в), <i>мка</i> , не более	2			
Частота генерации (при напряжении коллектора минус 5 в и токе эмиттера 5 ма), <i>Мгц</i> , не менее	200	400		
Постоянная времени в цепи обратной связи (при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 5 ма и частоте $5 \cdot 10^3$ кгц), <i>мкмсек</i> , не более	300	200		
Емкость коллектора (при напряжении коллектора минус 5 в и частоте $5 \cdot 10^3$ кгц), <i>пф</i> , не более	5			

* при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 5 ма и частоте 1 кгц.

Предельно-допустимые эксплуатационные данные

Напряжение коллектор—база не более минус 5 в

Напряжение коллектор—эмиттер при температуре окружающей среды:

до плюс 50°C не более минус 8 в

от плюс 50°C до плюс 70°C не более минус 5 в

Ток коллектора не более 20 ма

Мощность, рассеиваемая транзистором, при температуре окружающей среды:

до плюс 50°C не более 100 мвт

при плюс 70°C не более 30 мвт

В интервале температур от плюс 50°C до плюс 70°C мощность, рассеиваемая транзистором, снижается по линейному закону.

Диапазон температур окружающей среды от минус 60°C до плюс 70°C.

Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:

золота — 0,0302 мг,

серебра — 52,762 мг.

Указания по эксплуатации

1. При включении транзисторов в схемы, находящиеся под напряжением, коллекторный контакт должен присоединяться последним, а отключаться первым.
2. Транзисторы должны быть жестко закреплены за корпус.
3. Не рекомендуется располагать транзисторы вблизи нагреваемых элементов схемы.
4. Пайка транзисторов не допускается.
5. В случае беспанельного использования транзисторов рекомендуется приварить точечной сваркой к стержневым электродам и к корпусу транзистора дополнительные выводы и последние впаивать в схему. При этом тонкие выводы эмиттера и базы рекомендуется откусывать на расстоянии 3 мм от корпуса.
6. Рекомендуется эксплуатировать транзисторы при мощности рассеивания не более 0,6 P мах, напряжении коллектора не более 4 в и токе коллектора не более 15 ма, где:
P мах — предельно-допустимая мощность при максимально-возможной в аппаратуре температуре.

В случае выхода транзистора из строя заполните следующие данные и отошлите поставщику.

Дата получения « . . . »	196	г.
Дата установки « . . . »	196	г.
Дата снятия с эксплуатации « . . . »	196	г.
Количество отработанных часов		
Краткая характеристика использования		
.		
.		
Причины снятия с эксплуатации		
.		
.		
Наименование и адрес потребителя		
.		
Дата заполнения « . . . »	196	г.
Подпись заполнявшего		